

首 页 成果 | 机构 | 登记 | 资讯 | 政策 | 统计 | 会展 | 我要技术 | 项目招商 | 广泛合作

科技频道 节能减排 | 海洋技术 | 环境保护 | 新药研发 | 新能源 | 新材料 | 现代农业 | 生物技术 | 军民两用 | IT技术

国科社区 博客 | 技术成果 | 学术论文 | 行业观察 | 科研心得 | 资料共享 | 时事评论 | 专题聚焦 | 国科论坛



国防科工 | 航空航天 | 计算机与网络 | 汽车与车辆 | 船艇 | 新材料与新工艺 | 能源与环保 | 光机电 | 通信
专题资讯

当前位置：科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 亚微米、深亚微米CMOS电路用薄层外延硅材料

请输入查询关键词

科技频道

搜索

亚微米、深亚微米CMOS电路用薄层外延硅材料

关 键 词： 硅 外延生长 集成电路 半导体材料

所属年份： 2001

成果类型： 应用技术

所处阶段： 中期阶段

成果体现形式： 新材料

知识产权形式：

项目合作方式： 其他

成果完成单位： 中国科学院半导体研究所

成果摘要：

该型材料主要用于亚微米、深亚微米CMOS工艺集成电路的制造。研究中开发了Φ4-6英寸P/P+、N/N+ CMOS外延硅材料；解决了CMOS硅外延生长、外延吸杂关键技术；探讨了外延生长工艺中本征吸杂与各种外吸杂作用的机制、吸杂效率、吸杂稳定性及对硅外延片质量影响；提出了气相腐蚀、调制掺杂、重掺硅衬底片平整度改进的新工艺技术途径，建立了完整的亚微米、深亚微米CMOS电路用P/P+、N/N+硅外延片生长技术规范，实现了Φ4-6英寸P/P+、N/N+ CMOS硅外延片批量生产。

成果完成人： 王启元；

[完整信息](#)

行业资讯

- 管道环氧粉末静电喷涂内涂层...
- 加氢处理新工艺生产抗析气变...
- 超级电容器电极用多孔炭材料...
- 丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆的...
- 库尔勒香梨排管式冷库节能技...
- 高温蒸汽管线反射膜保温技术...
- 应用SuperIV型塔盘、压缩机注...
- 非临氯重整异构化催化剂在清...
- 利用含钴尾渣生产电积钴新工艺
- 引进PTA生产线机械密封系统的...

成果交流

推荐成果

· 新型稀土功能材料	04-23
· 低温风洞	04-23
· 大型构件机器缝合复合材料的研制	04-23
· 异型三维编织增减纱理论研究	04-23
· 飞机炭刹车盘粘结修复技术研究	04-23
· 直升飞机起动用高能量密封免...	04-23
· 天津滨海国际机场预应力混凝...	04-23
· 天津滨海国际机场30000立方米...	04-23
· 高性能高分子多层复合材料	04-23

Google提供的广告

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航 | 常见问题

国家科技成果网

京ICP备07013945号